

### SILICON ZENER DIODES SILIZIUM-ZENERDIODEN

Type	Maximum ratings ● Grenzdaten				$U_Z$	$r_z$	$I_Z$	$I_F$ at $U_F$ bei	$U_F$	$I_R$ ( $U_R = 1V$ )	Case Gehäuse
Typ	$I_Z$	$I_Z$	$P_d$	$R_{thjc}$	V	$\Omega$	mA	mA	V	$\mu A$	
	mA	mA	W	K/mW							
<b>DIODES WITH POWER DISSIPATION 280 mW ● DIODEN MIT VERLUSTLEISTUNG 280 mW</b>											
KZY81	36		0,28 <sup>4)</sup>	0,012	5,8—7,5 6,0—7,4	< 8 < 30	5 1	50	< 1	< 0,1	D17
KZY82	33		0,28 <sup>4)</sup>	0,012	7,0—8,5 6,8—8,4	< 6 < 12	5 1	50	< 1	< 0,1	D17
KZY83	30		0,28 <sup>4)</sup>	0,012	8,0—9,5 7,8—9,4	< 10 < 18	5 1	50	< 1	< 0,1	D17
KZY84	26		0,28 <sup>4)</sup>	0,012	9,0—10,5 8,8—10,5	< 12 < 25	5 1	50	< 1	< 0,1	D17
KZY85	23		0,28 <sup>4)</sup>	0,012	10—12 9,8—12	< 15 < 30	5 1	50	< 1	< 0,1	D17
KZY86	20		0,28 <sup>4)</sup>	0,012	11,2—14 10,8—14	< 18 < 35	5 1	50	< 1	< 0,1	D17
<b>DIODES WITH POWER DISSIPATION 10 W ● DIODEN MIT VERLUSTLEISTUNG 10 W</b>											
		<sup>2) 3)</sup>		K/W							
KZY03	320	1300		3,5	6—7,8	< 1	1000	300	< 1	< 50	D20a
KZY04	270	1100		3,5	7—9,2	< 1	1000	300	< 1	< 50	D20a
KZY05	240	970		3,5	8—10,2	< 2	500	300	< 1	< 50	D20a
KZY06	210	850		3,5	9,4—11,6	< 2	500	300	< 1	< 50	D20a
KZY07	190	750	2,6	3,5	10,6—13,2	< 2	500	300	< 1	< 50	D20a
KZY08	170	670	10 <sup>3) 2)</sup>	3,5	12—14,8	< 2	500	300	< 1	< 50	D20a
KZY09	150	600		3,5	13,6—16,8	< 3	500	300	< 1	< 50	D20a
KZY10	135	530		3,5	15,2—19	< 3	500	300	< 1	< 50	D20a
KZY11	120	470		3,5	16,8—21	< 3	250	300	< 1	< 50	D20a
KZY12	105	420		3,5	19—23,6	< 3	250	300	< 1	< 50	D20a
KZY13	95	370		3,5	21,6—26,6	< 3	250	300	< 1,3	< 50	D20a
KZY14	85	330		3,5	24,2—29,8	< 4	250	300	< 1,3	< 50	D20a
KZY15	75	300		3,5	27—33	< 4	250	300	< 1,3	< 50	D20a

<sup>2)</sup> With Al cooling surface ● Mit Al-Kühlfläche 100×100×2 mm,  $\vartheta_a \leq 25^\circ C$

<sup>3)</sup> With Al cooling surface ● Mit Al-Kühlfläche 160×160×2 mm,  $\vartheta_a \leq 60^\circ C$

<sup>4)</sup> Without cooling surface ● Ohne Kühlfläche;  $\vartheta_a \leq 50^\circ C$

### SYMMETRICAL MULTILAYER SILICON DIODES DIAC SYMMETRISCHE SILIZIUM-MEHRSCICHTDIODEN DIAC

Type	Maximum ratings ● Grenzdaten			$U_{BO}$	$I_{BO}$	$\Delta U$ at I	$ U_{BO1} - U_{BO2} $	Case Gehäuse
Typ	P	$I_{FRM}$ <sup>1)</sup>	$\vartheta_a$	V	mA	$\Delta U$ min bei	V	
	mW	A	$^\circ C$			V		
KR105	300	1	-55...+100	26 ± 4	< 1	4	< 5	Di2
KR106	300	1	-55...+100	32 ± 4	< 1	4	< 5	Di2
KR107	300	1	-55...+100	38 ± 4	< 1	4	< 5	Di2

<sup>1)</sup>  $t = 20 \mu s$